








	<h2>SI1422DH-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI1422DH-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 4A SC70-6</p> <p>Datenblätter:  SI1422DH-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 15393 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI1422DH-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 4A SC70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	15393 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 12V 4A (Tc) 1.56W (Ta), 2.8W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	6-TSSOP, SC-88, SOT-363
Supplier Device-Gehäuse	SC-70-6 (SOT-363)
Verlustleistung (max)	1.56W (Ta), 2.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	26 mOhm @ 5.1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	725pF @ 6V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI1422DH-T1-GE3CT

SI1422DH-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI1422DH-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI1422DH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI1422DH-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI1424EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 4A SOT-363</p>	 <p>SI1419DH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 200V 0.3A SC70-6</p>	 <p>SI1424EDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 4A SOT-363</p>	 <p>SI1417EDH-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 2.7A SC70-6</p>
 <p>SI1417EDH-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 2.7A SC70-6</p>	 <p>SI1422DH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 4A SC70-6</p>	 <p>SI1417EDH-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 12V 2.7A SC70-6</p>	 <p>SI1424EDH Vishay Vishay SOT-23-6</p>

heiße Teile

Mehr

 SI1407DL-T1-E3	 SI1407DL-T1-GE3	 SI1410EDH	 SI1410EDH-T1	 SI1410EDH-T1-E3
 SI1410EDH-T1-E3	 SI1410EDH-T1-GE3	 SI1413DH-T1	 SI1413EDH	 SI1413EDH-T1
 SI1413EDH-T1-E3	 SI1413EDH-T1-GE3	 SI1413EDH-T1-GE3	 SI1413EDH-T1-GE3	 SI1414DH-T1-GE3
 SI1414DH-T1-GE3	 SI1416EDH-T1-GE3	 SI1416EDH-T1-GE3	 SI1417DH-T1-E3	 SI1417DH-T1-GE3
 SI1417EDH-T1	 SI1417EDH-T1-E3	 SI1417EDH-T1-E3	 SI1417EDH-T1-GE3	 SI1417EDH-T1-GE3
 SI1422DH-T1-GE3	 SI1424EDH-T1-GE3	 SI1424EDH-T1-GE3	 SI1426DH-T1-E3	 SI1426DH-T1-E3
 SI1426DH-T1-GE3	 SI1426DH-T1-GE3	 SI1427EDH-T1-GE3	 SI1427EDH-T1-GE3	 SI1428EDH-T1-GE3
 SI1428EDH-T1-GE3	 SI1433DH-T1	 SI1433DH-T1-E3	 SI1433DH-T1-E3	 SI1433DH-T1-GE3
 SI1433DH-T1-GE3	 SI1441EDH-T1-GE3	 SI1441EDH-T1-GE3	 SI1442DH-T1-GE3	 SI1442DH-T1-GE3
 SI1443EDH-T1-GE3	 SI1443EDH-T1-GE3	 SI1467DH-T1-GE3	 SI1467DH-T1-GE3	 SI1469DH-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited